

## ⑪ 公開特許公報 (A) 昭64-37743

⑫ Int. Cl.

G 11 B 11/10  
 C 22 C 30/00  
     38/00  
 H 01 F 10/14  
     10/16

識別記号

305

序内整理番号

A-8421-5D  
 6735-4K  
 6813-4K  
 7354-5E  
 7354-5E

⑬ 公開 昭和64年(1989)2月8日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

⑭ 発明の名称 光磁気記録媒体

⑮ 特願 昭62-192642

⑯ 出願 昭62(1987)8月3日

⑰ 発明者 桐野文良 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑰ 発明者 太田憲雄 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑰ 発明者 萩原典之 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

⑰ 出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑰ 出願人 日立マクセル株式会社 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

⑯ 代理人 弁理士 小川勝男 外1名

## 明細書

## 1. 発明の名称

光磁気記録媒体

## 2. 特許請求の範囲

1. レーザー光により書き込み、消去、読み出しを行う光磁気記録媒体において、情報を記録する媒体として、希土類元素と鉄族元素からなりこれにNb, Ti, Ta, Cr, Alの内より選ばれる少なくとも1種類の元素( $X_1$ )とPt, Au, Pd, Phの内から選ばれる少なくとも1種類の元素( $X_2$ )を添加した合金を用い、かつこの合金が磁化の容易軸が基板面と垂直方向であることを特徴とする光磁気記録媒体。

2. 特許請求の範囲第1項記載において、前記合金が非晶質であることを特徴とする光磁気記録媒体。

3. 特許請求の範囲第1項記載において、前記元素 $X_1$ および $X_2$ の両方またはいずれか一方を、媒体表面または基板あるいは下地層と媒体の界面近傍で濃度を高くしたことを特徴とする光磁

気記録媒体。

4. 特許請求の範囲第1項記載において、前記希土類元素として、Tb, Gd, Dy, Ho, Pr, Ceの内から選ばれる少なくとも1種類の元素を用いたことを特徴とする光磁気記録媒体。

5. 特許請求の範囲第1項記載において、前記鉄族元素として、FeまたはCo、或いはその両方の元素を用いたことを特徴とする光磁気記録媒体。

6. 特許請求の範囲第1項記載において、前記希土類-鉄族元素系(REE-TM)と添加元素 $X_1$ と $X_2$ とが $(REE-TM)_{1-x}(X_1X_2)_x$ なる組成で表わされ、組成が $0 < x \leq 1.5$ ,  $x \neq 0$ かつ $b \neq 0$ で表わされる範囲であることを特徴とする光磁気記録媒体。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は光磁気記録媒体に係り、特に高信頼性を有する光磁気記録媒体に関する。

## 〔従来の技術〕

近年、情報化社会の進展にともない高密度記録が注目されている。特に、光を用いた情報記録は高密度記録が可能で各種方式が研究されている。中でも、光磁気記録は情報の交換が可能な光記録として最も実用化が近いといわれている。現在この光磁気記録用の材料として最も有観視されているのが、希土類-鉄族元素を中心として合金である。ところが希土類元素を含むこれら合金は、腐食し易いので、このまま記録媒体として用いたのでは高信頼性を有する光磁気ディスクを得ることができなかつた。そこで、従来技術では、光磁気特性を低下させず、かつ腐食に対する抑制効果のある元素を添加することにより信頼性を向上させていた。その例として、特開昭61-84004号、61-87306号、61-117749号、61-84802号、61-107555号、61-113155号、61-51806号、61-6807号等をあげることができる。

## 〔発明が解決しようとする問題点〕

上記従来技術では、希土類-鉄族元素を主体と

光学特性を低下させることなく、酸食・酸化・孔食の光磁気記録膜の典型腐食を同時に抑制することができ、長寿命で高信頼性を有する光磁気記録媒体を提供することにある。

## 〔問題点を解決しようとする問題点〕

上記目的は、光磁気記録用材料としての希土類-鉄族元素を主体とする垂直磁気異方性を有する合金系に（1）磁気特性的には鉄族元素の磁気モーメントをみかけ上増大させ、耐食的には孔食には著しく強く酸食或いは酸化に弱い元素（X<sub>1</sub>）と、（2）鉄族元素の磁気モーメントをみかけ上減少させ、耐食的には酸化及び孔食には著しく強く孔食にはやや弱い元素（X<sub>2</sub>）とを同時に添加することにより達成される。

## 〔作用〕

添加元素X<sub>1</sub>は、磁気特性的には鉄族元素のモーメントをみかけ上減少させる。また耐食的には酸食や酸化には著しく強いが孔食にはやや弱い。一方、添加元素X<sub>2</sub>は、磁気特性的には鉄族元素のモーメントをみかけ上増大させる作用がある。

する光磁気記録材料に腐食抑制に効果のある金属元素を添加して耐食性を向上させていた。光磁気材料に生じる腐食としては、以下の3つのタイプに分類される。その第1は酸化で、これは主に大気中の酸素が関与する。第2は酸食で、これには主に大気中の水分がこの進行に寄与している。そして第3は孔食で、これは局部的に起る腐食であり、ハロゲン等の腐食性イオンが関与する。実際の環境ではこれら3つのタイプの腐食が同時に起るので、3つのタイプの腐食を同時に抑制し、かつ磁気特性の低下をまなすことのないようにしなければならない。ところが、上記従来技術では、先の3つのタイプの腐食を同時に抑制することはできなかつた。例えば、酸化や酸食を抑制するための添加元素によつては孔食を十分に抑制できなかつたり、或いはその逆であつたりする。腐食の抑制は、ディスクの信頼性及び寿命にかかる重要な問題で、ディスク実用化に向けて絶対に解決しなければならない最も重要な課題である。

本発明の目的は、光磁気記録膜の磁気及び磁気

また、耐食性的には孔食には著しく強いが酸食には弱い。

耐食性向上のみを目的とするならば添加元素濃度が高い程効果は増大することは自明である。しかし磁気特性の内、電気信号特性を支撐するKe<sup>rr</sup>回転角、データの保持特性を左右する保磁力、さらにKe<sup>rr</sup>回転角や記録感度を左右するキュリー温度等の制約から添加にはおのずと限界が存在していた。添加元素濃度を高くしすぎると、これら垂直磁気異方性エネルギーを議論する前に、先の磁気及び磁気光学特性が低下して、光磁気記録膜として用いることができなかつた。

そこで、磁気特性的にも耐食的にも互いに相補的な関係にある2種類の元素X<sub>1</sub>及びX<sub>2</sub>を同時に添加することにより、磁気特性を低下させずに先の3つのタイプの腐食を著しく抑制することができる。さらに、この性質を利用すると、X<sub>1</sub>とX<sub>2</sub>の濃度を制御することにより、先の磁気特性を自由に制御できる。添加できるX<sub>1</sub>とX<sub>2</sub>の組合せは、垂直磁気異方性エネルギーにより支配され

る。垂直磁化膜として安定に存在できる範囲として、 $X_1 + X_2$  は 1.5% 程度まで添加でき、これは従来の手法の 3 倍以上の量である。

#### 〔実施例〕

以下、本発明を実施例 1 ~ 4 を用いて詳細に説明する。

#### 〔実施例 1〕

第 1 図は作製した光磁気ディスクの断面構造を示す模式図である。基板の凹凸は、案内溝を模式的に示したものである。このディスクの作製手順は次のとおりである。

まず、表面に凹凸パターンのついたガラス、またはプラスチック製の基板 (1) (5°) 上に、下地膜 (2) として  $\text{Si}_3\text{N}_4$  膜を 800 Å の膜厚にスパッタリング法にて作成した。その時のスパッタ条件は、ターゲットは  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、放電ガスに  $\text{Ar} / \text{N}_2 (= 85 / 15)$  を用い、投入高周波電力密度 4.5 W/cm<sup>2</sup>、放電ガス圧  $1.0 \times 10^{-2}$  (Torr) である。スパッタ装置としてはインラインタイプの通過型マグネットロンスパッタ装置を

用い、下地膜につづき以下、記録膜 (3)、保護膜 (4) と順次積層した。本実施例では、 $\text{TbFeCo}$  膜に  $X_1$

の元素として  $\text{Nb}$  を、 $X_2$  の元素として  $\text{Pt}$  を添加した。記録膜 (3) の形成は、次のように行なつた。ターゲットに  $\text{FeCoNb}$  の合金円板上に、 $\text{Tb}$  チップ及び  $\text{Pt}$  チップをそれぞれ均一になるよう配設した複合体ターゲットを用いた。スパッタは、放電ガスに  $\text{Ar}$ 、投入高周波電力密度: 4.5 W/cm<sup>2</sup>、放電ガス圧  $5 \times 10^{-2}$  (Torr) の条件で作製し、膜厚 1000 Å の膜を形成した。ひきづき  $\text{Si}_3\text{N}_4$  保護膜 (4) を形成した。作製は、ターゲット及び雰囲気ガスは先の下地膜 (2) 形成の場合と同一で、条件もスパッタガス圧を  $2 \times 10^{-2}$  (Torr) とした以外は下地膜 (2) 作製の場合と同一とした。形成した膜の厚さは、2000 Å とした。このようにして作成した光磁気ディスクの磁気特性は、 $\theta_s = 0.60^\circ$ 、 $H_c = 7 \text{ KOe}$ 、 $T_c = 200^\circ\text{C}$ 、 $T_{comp} = 80^\circ\text{C}$  で、膜組成は  $(\text{Tb}_{40}\text{Fe}_{40}\text{Co}_{20})_{88} (\text{Nb}_{40}\text{Pt}_{60})_{12}$  であった。ここ

で、 $(\text{TbFeCo})$  に  $X_1$  の元素である  $\text{Nb}$  のみを加えてゆくと、添加量の増加とともにカーブ回転角:  $\theta_s$ 、キュリー温度:  $T_c$  は減少してゆき。(曲線 5 ~ 8) 反射率:  $R$  (9, 10) は変化しなかつた。この様子を第 2 図に示す。また、 $X_2$  の元素である  $\text{Pt}$  のみ添加してゆくと  $\text{Nb}$  の場合とは逆に第 3 図曲線 7, 8, 10 に示すように、 $R$  、 $\theta_s$  及び  $T_c$  ともに増大してゆく。したがつて、 $\text{Nb}$  質と  $\text{Pt}$  質との比及び  $\text{Nb}$  、 $\text{Pt}$  の総量を制御することにより  $\theta_s$ 、 $T_c$  一定のままで、 $\text{Pt}$  或いは  $\text{Nb}$  のみを添加した場合より磁気特性を低下させることなく、耐食性向上元素を多く添加できる。さらに、 $X_2$  の元素として  $\text{Pt}$  を添加すると、膜の反射率も 1.0 ~ 1.5% 程度増大し、ディスクの電気信号特性(特に再生出力)が 1 ~ 2 dB 向上した。

次に耐食性のテストのために、本実施例で作製した光磁気ディスク及び本実施例の記録膜をガラス基板上に作製した試料を、各々 60 °C ~ 95% RH 中に放置した。そして膜寿命評価法と

して、ディスクについては電気信号特性(搬送波対雜音比: C/N 比)により評価し、ガラス基板上に直接形成した試料については飽和磁化の変化にて評価した。比較のために、 $X_1$  のみ添加した  $\text{TbFeCoNb}$ 、 $X_2$  のみ添加した  $\text{TbFeCoPt}$ 、および  $X_1$ 、 $X_2$  共添加しない  $\text{TbFeCo}$  での結果を合わせて第 3 図に示した。この図曲線 1 4 ~ 1 6 に示すように、 $\text{TbFeCoPt}$  膜は  $\text{TbFeCo}$  膜よりも腐食に対して弱く  $\text{Pt}$  は腐食を促進している。これに対し、 $\text{TbFeCoNb}$  膜及び  $\text{TbFeCoNbPt}$  膜は腐食に対してはほぼ同等の耐食性を有している。これは C/N の結果(曲線 1 1 ~ 1 3)も支持している。次に、孔食の発生であるが、この試験は 1 N - NaCl  $\text{aq}$  中にガラス上に作成した試料片を没漬し、その時の光透過率の経時変化を測定した。用いた光の波長は 822 nm、スポット径は  $7 \times 6 \text{ mm}^2$  である。その結果を第 4 図に示す。まず、添加元素を含まない  $\text{TbFeCo}$  系では曲線 1 7 に示すように、直徑 1.0 ~ 2.0  $\mu\text{m}$  の円形の穴が無数にあっていた。また、 $\text{TbFeCoNb}$  膜(曲線 1 8)では 1 ~ 2  $\mu\text{m}$  の

小穴がわずかに発生したのみであつた。これに対して TbFeCoPt 膜及び TbFeCoNbPt 膜 (曲線 1, 9) では孔食の発生がほとんどみられなかつた。このように TbFeCoNbPt 膜及び TbFeCoPt 膜は孔食に対して強いことがわかつた。

以上のことから、本実施例の TbFeCoNbPt 膜は酸化、混食及び孔食の三つの腐食に対して著しく強く、高耐食性を有する光磁気磁性材料であることがわかる。また、Nb の代わりに Ti, Ta, Cr, Al に変えて同様の磁気特性及び耐食性の効果が得られ、Pt に変えて Rh, Pd, Au を用いても同様であつた。またこのディスクの寿命を推定したところ 1.5 ~ 20 年であることがアーレニウスプロットよりわかつた。従来の 1 元素添加では 10 年程度であつたので、1.5 ~ 2 倍に寿命を伸すことができた。

#### 〔実施例 2〕

作製した光磁気ディスクの構造は、実施例 1 と同様で第 1 図に示すとおりである。基板 (1)、下地膜 (2) 保護膜 (4) は、実施例 1 と同様の

材料を用い、同じスパッタ条件で形成した。異なるのは光磁気磁性材料として  $(Gd_{70}Tb_{20})_{28}$  ( $Fe_{0.8}Co_{0.2})_{67}$  ( $Nb_4Pt_6)_7$  を用いた点である。

スパッタターゲットとして 5 インチの FeCoNbPt の合金ターゲットを用い、その上に Gd-Tb 合金チップ ( $1.0 \times 1.0$  mm 角) をはつたものを使用し、Ar を放電ガスとして、実施例 1 と同様のスパッタ条件にて記録膜を作成した。このようにして作成した光磁気ディスクと、ガラス基板上に直接スパッタして製膜した試料とを各々 60°C - 95% RH 中に保存した場合において、ガラス基板上に形成した膜については飽和磁化  $M_s$  の経時変化を、そして光磁気ディスクについては C/N 比の経時変化をそれぞれ測定した。用いた光磁気磁性材料は、 $\theta_s = 0.42^\circ$ 、 $T_c = 200^\circ C$ 、 $T_{consp} = 85^\circ C$ 、 $H_c = 5 K Oe$  であつた。C/N 及び  $M_s$  の経時変化の様子を第 5 図に示す。比較のために Nb, Pt を含まない、すなわち X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> 共に添加しない GdTbFeCo 系を用いた光磁気磁性材料について同様の試験を行なつた結果もい

つしよに示した。この結果から、本実施例の GdTbFeCoNbPt 系では 2000 時間をこえても C/N の変化は曲線 2.0 に示すようにほとんどなく、NbPt を含まない系の変化 (曲線 2.1) と比較しても大きく耐食性が向上していることがわかる。また、 $M_s$  の変化は、本発明を用いた GdTbFeCoNbPt 系では曲線 2.3 に示すように放電初期で約 5% の増加がみられ、それ以後はほぼ一定となつた。

これに対し、Nb, Pt を含まない系では曲線 2.2 に示すように、放電時間の経過とともに増大してゆく。このなうに本実施例のディスクは著しく混食に対して強いことがわかる。次に孔食について調べた。手法は実施例 1 と同様で、IN-NaCl 80% 中に投漬したときの光透過率の経時変化について検討した。その結果を第 6 図に示した。この図より GdTbFeCo 系薄膜では投漬時間の経過とともに孔食が発生し光透過率は増大してゆく (曲線 2.4)。これに対して、本実施例の GdTbFeCoNbPt 系では、投漬の初期でわずかの光透過率の増加がみられた (曲線 2.5) が、それ以後

はほぼ一定となつた。顕微鏡観察の結果、ごくわずかな 1  $\mu m$  程度の微小の孔食がみられるが、この膜ではそれ以上孔食の発生及び発した孔の成長もみられなかつた。このように Nb 及び Pt を添加すると、孔食自身を抑制するだけでなく、発生した孔の成長の抑制する効果がある。

このように光磁気特性をまったく下げることなく、混食及び孔食を同時に著しく抑制することができる効果がわかる。この効果は、Nb の代わりに Ti, Ta, Al, Cr を用いても Pt の代わりに Rh, Pd, Au を用いてもまったく変わらない効果が得られた。また、このディスクの寿命を推定したところ、1.5 ~ 20 年とこれら元素を含まない場合の約 1 年、一元素添加で約 8 年と比べると約 2 倍にその寿命を伸すことができた。

#### 〔実施例 3〕

作製した光磁気ディスクの構造は、実施例 1 と同様で第 1 図に示すとおりである。ディスク基板 (1)、下地膜 (2) 及び保護膜 (4) は、実施例 1 と同じ材料及び同一の条件で形成した。異なる

のは記録膜 (3) の磁性材料で、 $(\text{Tb}_{0.7}\text{Nd}_{0.3})_{28}$   $(\text{Fe}_{0.8}\text{Co}_{0.2})_{17}$   $(\text{Cr}_{0.8}\text{Pd}_{0.2})_7$ なる組成の合金ターゲットを用いて、同組成の記録膜とした。放電ガスに Ar を使用し、実施例 1 と同様のスパッタ条件にて膜形成を行なつた。また、上記組成中の Nd の代りに Pr または Ce を用いた光磁気ディスク及び比較例として Pd を含まない TbNd (Ce または Pr) FeCoCr 系光磁気ディスクを作製した。

上記作製のディスクを 60°C - 95% RH なる高温高湿環境中に放置したときの C/N 比及びエラーレイトの経時変化を測定した。その結果を第 7 図に示す。比較のために Pd 破いは Cr のみの試料を同一の環境中に放置したときの C/N 比及びエラーレイトの経時変化も合わせて示した。このディスクをディスク中心に近い内周部分、ディスクの内周部に近い外周部分、そして両者の中间の中周部分の 3 つの部分に分けて考えた場合、外周部分が最も腐食し、従来の光磁気ディスクでは特に孔食が発生した。そこで C/N 及びエラーレイトはディスクの外周部分で評価した。

TbFeCoCr や TbFeCoPd 系と何ら差がなく垂直磁気異方性エネルギーも  $K_u = 6 \times 10^4 \text{ J/m}^3$  と十分大きな値を有していた。また、キュリー温度も  $T_c = 200^\circ\text{C}$ 、補償温度は  $T_{comp} = 80^\circ\text{C}$  であった。

#### 〔実施例 4〕

本実施例は、光磁気材料に GdTbCoTiRh 系を用いた場合である。作製した光磁気ディスクの断面構造は第 8 図に示すとおりで、次に述べる手法により製造した。まず、ガラスまたはプラスチックの基板 (28) 上に GdTbCoTiRh 系光磁気記録膜 (29) をスパッタリング法により形成した。ターゲット I として  $\text{Gd}_{0.9}\text{ Tb}_{0.1}$  なる組成の合金チップを Co 基板上に均一に配置した複合ターゲットを、そしてターゲット II として  $\text{Ti}_{0.9}\text{ Rh}_{0.1}$  なる組成の合金基板をそれぞれ用いた。記録膜の形成は DC スパッタ法により行なつた。添加元素の Ti, Rh の濃度は、ターゲット基板間に流れる乾燥により制御できる。そして、Ti 及び Rh の濃度を、基板と記録膜の界面近傍及び膜表面近傍で高くなるように制御し、組成勾配を設けた。また比較例と

磁性元素の希土類-鉄族元素よりなる非晶質合金に Cr を添加することでかなり孔食の発生が抑制できたが、コードデータ記録用としては不十分であつた。ところが、この系に Cr と Pd を同時に添加することにより、この孔食の発生を大きく抑制することができた。まず、C/N 比は、本発明のディスクで曲線 26 に示すように 2000 時間経過後付近よりごくわずかずつ減少はじめたのに対し、本発明を用いない場合では曲線 27 に示すように 1500 時間経過後から C/N 比が減少した。またエラーレイトで比較するとこの差はさらに明確で、本発明のディスクでは曲線 26' エラーレイトはほとんど変化ないが、Cr と Pd を同時に含まない場合 (Cr のみを含有) は、曲線 27' に示すように 1000 時間経過後から増加はじめ、2500 時間後では 1 衍以上増加した。この変化は、TbPrFeCoCrPd 或いは TbCeFeCoCrPd 系でも同じであつた。

この記録膜について磁気特性について測定したところ、 $\theta_s = 0.38^\circ$ 、 $H_c = 8 \text{ KOe}$ 、と

して Ti 或いは Rh を含まないディスクを先と同様の手法にて形成した。

このようにして作製した光磁気記録膜の組成は、 $(\text{Gd}_{70}\text{Tb}_{30})_{0.28}\text{Co}_{0.67}$   $(\text{Ti}_{48}\text{Rh}_{52})_{0.10}$  であつた。この膜の磁気特性は、カーブ回転角:  $\theta_s = 0.40^\circ$ 、保磁力:  $H_c = 6 \text{ KOe}$ 、キュリー温度:  $T_c = 200^\circ\text{C}$ 、補償温度:  $T_{comp} = 80^\circ\text{C}$ 、垂直磁気異方性エネルギー:  $K_u = 4 \times 10^4 \text{ J/m}^3$  であつた。これは従来の GdTbFeCoTi または GdTbFeCoRh 系の最適組成における特性と何ら違いはみられなかつた。

次に、これらディスクの寿命及び信号性試験を行なつた。手法及び条件は、先の実施例と同様である。環境は、60°C - 95% RH 中に放置したときの C/N 及びエラーレイトの経時変化をそれぞれ測定した。まず、本発明を用いて作製したディスク (比較例 1) は、曲線 30 に示すように 60°C - 95% RH の環境中に 3000 時間放置後で C/N 及びエラーレイトともほとんど変化しなかつた。これを比較用のディスクと比べると、

Rhのみを含むディスクでは図版31に示すようにC/Nは1.500時間経過後より減少しはじめ2000時間を超えると急激に減少した。しかしながら、エラーレイトは2000時間経過後から徐々に増加しはじめ、3000時間経過後で約1桁大きくなつた。また、Tiのみしか含まない光磁気材料を用いたディスク(比較例II)では、図版32に示すようにC/Nの変化は比較例Iと比べて小さく、2000時間を超えたあたりより徐々に減少しはじめた。ここで、C/Nが3dB低いのは、Rhを含まないため、反射率が10%低いのである。しかし、エラーレイトは1000時間経過後から徐々に増加しはじめ、さらに2000時間経過後から急激に増大した。以上の結果から磁気特性的にもまた耐食性的にも相補的に二種類の元素を同時に添加することにより、磁気特性を低下させず、耐食性について単なる孔食と湿食に対し相加効果にとどまらず、大きな相乗効果が認められた。

さらに本実施例のように膜厚方向に濃度勾配を

再生特性の向上に大きく寄与する。

さらに、本発明を用いると保護膜を形成しなくとも十分長い寿命を有する光磁気ディスクを得ることができる。そのため、製造工程の簡略化にも効果がある。

以上の効果の総集として、長寿命かつ高信頼性を有する光磁気ディスクの製造を可能にした。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図および第8図は本発明の実施例における光磁気ディスクの断面構造を示す模式図、第2図は各種光磁気記録膜を60°C-95%RH中に放置したときのC/N及びMsの経時変化を示す図、第3図は光磁気記録膜のθs, Tc, Rの添加元素濃度依存性を示す図、第4図は光磁気記録膜を1N-NaClaq中に浸漬したときの光透過率の経時変化を示す図、第5図、第7図および第9図は光磁気記録膜を60°C-95%RH中に放置したときのC/N及びMsの経時変化を示す図、第6図は光磁気記録膜を1N-NaClaq中に浸漬したときの光透過率の経時変化を示す図である。

設けると、通常の磁気特性が消失するような範囲でも記録膜としての使用が可能となり、これらが保護膜としての機能をももたせることができる。

#### 【発明の効果】

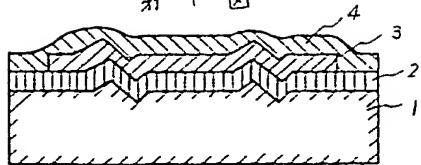
本発明によれば、磁気特性的には鉄族の磁気モーメントを増大させ、耐食的には孔食には強いが湿食に弱い元素(X2)と、磁気的には鉄族の磁気モーメントを減少させ、耐食的には湿食や酸化には強いが孔食に弱い元素(X1)とを同時に希土類-鉄族系合金に添加すると、磁気特性を低下させずに、酸化、湿食および孔食のすべての耐食性を向上させる効果がある。その場合、各元素が持つ固有の耐食性よりもさらに高耐食性がはかれ、二元素同時添加には相加効果ではなく相乗効果がある。また磁気特性は、希土類元素、鉄族元素、添加元素X1及び添加元素X2の各元素濃度を制御することにより、自由にコントロールできる。

また、X1で覆わされる元素には、記録膜表面での光の反射率を増大させる効果があり、記録/

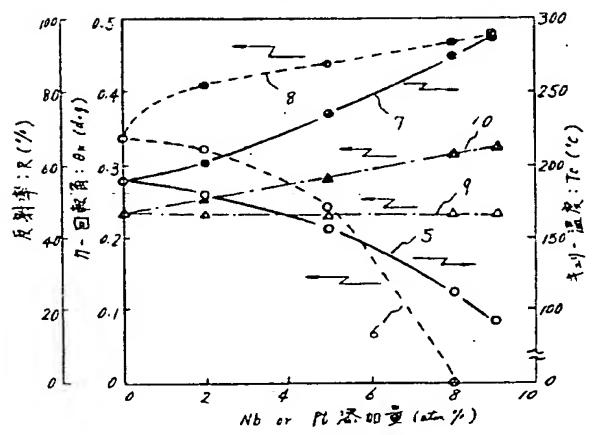
1…基板、2…下地膜、3…光磁気記録膜、4…保護膜、28…基板、29…光磁気記録膜。

代理人弁理士 小川勝男

第1図

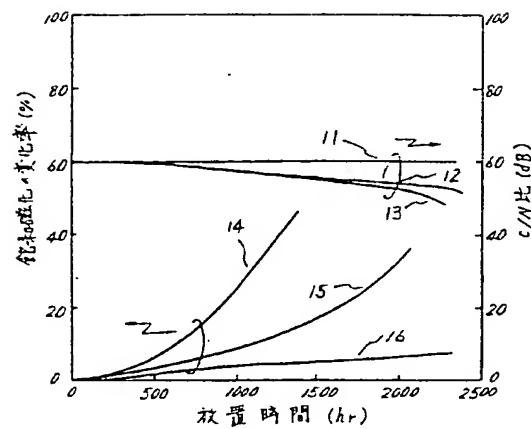


第2図



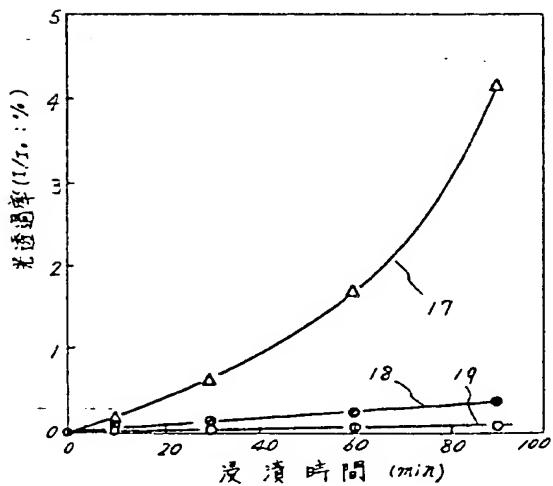
1 基板 5 TbFeCoNb合金膜  
2 下地膜 6 TbFeCoNb合金膜  
3 光磁気記録膜 7 TbFeCoNb合金膜  
4 保護膜 8 TbFeCoNb合金膜  
9 TbFeCoNb合金膜  
10 TbFeCoNb合金膜  
R - TbFeCoNb合金膜

第3図



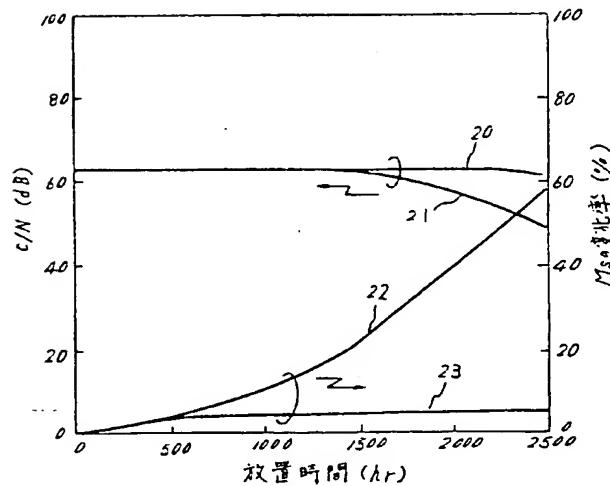
11 TbFeCoNb, TbFeCo膜  
12 TbFeCo膜の経時変化  
13 TbFeCoNb膜の経時変化  
14 TbFeCo膜の経時変化  
15 TbFeCoNb膜の経時変化  
16 TbFeCoNb, TbFeCo膜の経時変化

第4図



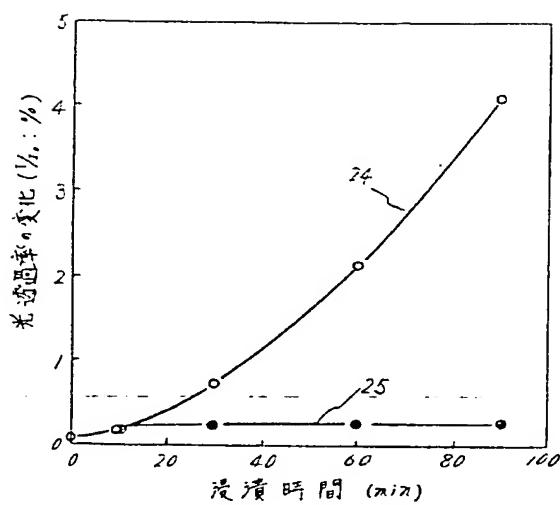
17 TbFeCo系膜の光透過率の経時変化  
18 TbFeCoNb系膜の光透過率の経時変化  
19 TbFeCoNb, TbFeCo膜の光透過率の経時変化

第5図

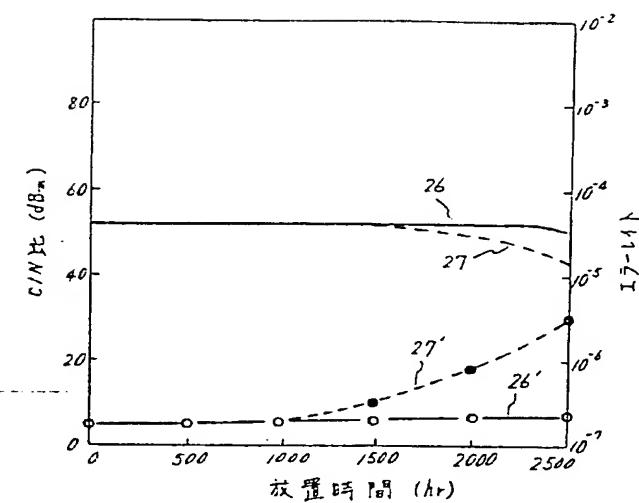


20 Gd Tb FeCoNb膜のC/Nの経時変化  
21 Gd Tb FeCo膜のC/Nの経時変化  
22 Gd Tb FeCo膜のMn%の経時変化  
23 Gd Tb FeCoNb膜のMn%の経時変化

第 6 図



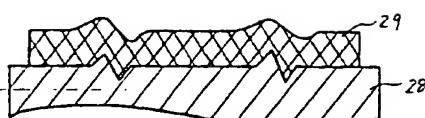
第 7 図



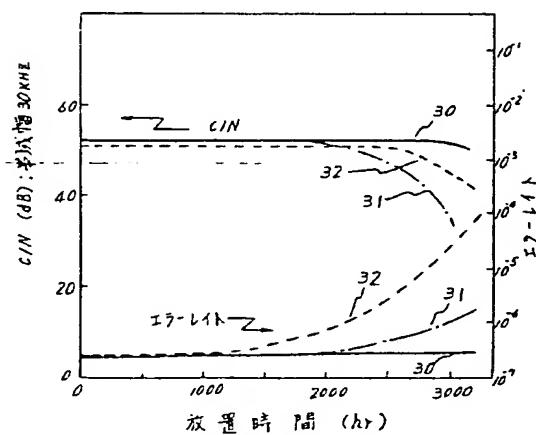
24  $Cd7bFeC_6$  製本 IN-NaCl  
25  $Cd7bFeC_6$  製本 IN-NaCl  
光透過率の時間変化

26, 26' 本透明のデータ  
27, 27' 比較例

第 8 図



第 9 図



28 基板  
29 光磁気記録層  
30 本透明のデータ  
31 比較例 (TFe含まない)  
32 比較例 (TFe含まない)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADING TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image  
problems checked, please do not report these problems to  
the IFW Image Problem Mailbox.**